

讣告

著名物理学家、我国低温物理和低温技术研究的开创者、中国科学院理化技术研究所研究员、中国科学院院士洪朝生先生因病医治无效，于2018年8月19日10时10分在北京不幸逝世，享年98岁。

洪朝生先生1940年毕业于清华大学电机工程系，1945年赴美国留学，1948年获麻省理工学院博士学位，后在美国普渡大学和荷兰莱顿大学卡末林·昂纳斯实验室工作。1951年回国，任中国科学院应用物理所（物理所）副研究员、研究员，兼清华大学、北京大学、中国科学技术大学物理系教授。1978年任中国科学院物理研究所副所长，1982年任中国科学院低温技术实验中心主任。1980年当选为中国科学院学部委员（院士）。

洪朝生先生于1950年在半导体锗单晶输运现象的实验中发现杂质能级上的导电现象，提出半导体禁带中杂质导电的概念，这一工作后被半导体物理界称之为“洪朝生效应”，成为无序系统电子输运现象实验研究的开端，引发了国际上对无序电子输运机制的探索。1953年在中国科学院物理研究所组建了国内第一个低温实验室，主持研制低温研究设备，先后在国内首次实现了氢的液化和氦的液化，并使该技术在国内外得以推广，为我国科学研究，特别是“两弹一星”的成功研制做出了贡献。1970年代领导低温科研队伍，完成了大型空间环境模拟系统KM3和KM4低温氦制冷系统的研制任务，提供卫星上天的空间环境模拟试验条件，为我国航天事业的发展做出了贡献。“KM4大型航天环模设备的研制”获得1985年国家科技进步一等奖。

洪朝生先生是第三届全国人大代表，第五、六、七、八届全国政协委员，曾任中国物理学会副理事长，中国制冷学会副理事长，国际低温工程委员会副主席。1978年获全国科技大会表彰的全国科技工作者，1989年获中国物理学会胡刚复物理奖，2000年获国际低温工程理事会门德尔松奖，2011年获美国低温工程和低温材料大会塞缪尔·科林斯奖。

定于2018年8月22日—8月24日在中国科学院理化技术研究所1号楼407会议室设立洪朝生先生追思堂，供各界人士吊唁。

洪朝生先生遗体告别仪式定于2018年8月25日上午10:00在八宝山殡仪馆东礼堂举行。

洪朝生先生治丧委员会

2018年8月19日

联系人：

冯丰，82543770，15120095080，fengfeng@mail.ipc.ac.cn

刘世雄，82543601，18910760838，liushx@mail.ipc.ac.cn

低温材料及应用超导研究中心

李来风，82543698，13501157463，lfli@mail.ipc.ac.cn

黄荣进，82543477，13811815171，huangrongjin@mail.ipc.ac.cn

传真：010-62554670

一、致唁电、送花圈的单位和个人，请于2018年8月23日15:00之前联系，以便登记、办理相关事宜。

二、25日上午8:45在理化所1号楼门前发车前往八宝山殡仪馆，如需乘车前往请联系登记。